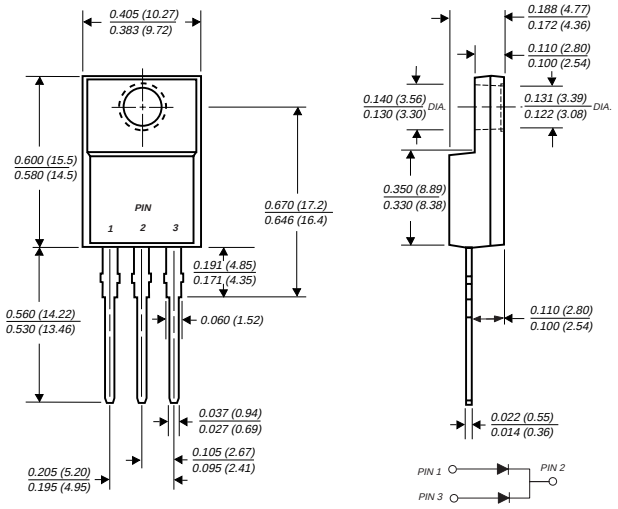
FEPF6AT THRU FEPF6DT

FAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER

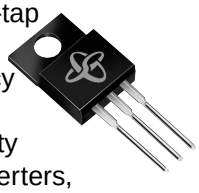
***Reverse Voltage** - 50 to 200 Volts* ***Forward Current** - 6.0 Amperes*

ITO-220AB



Dimensions in inches and (millimeters)

FEATURES



- Plastic package has carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- Dual rectifier construction, positive center-tap
- Glass passivated chip junctions
- Superfast recovery times for high efficiency
- Low power loss
- Low forward voltage, high current capability
- For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection applications
- High temperature soldering guaranteed: 250°C, 0.25" (6.35mm) from case for 10 seconds

MECHANICAL DATA

Case: JEDEC ITO-220AB molded plastic body over passivated chips
Terminals: Plated lead solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Polarity: As marked
Mounting Position: Any
Weight: 0.08 ounce, 2.24 grams
Mounting Torque: 5 in. - lb. max.

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

	SYMBOLS	FEPF6AT	FEPF6BT	FEPF6CT	FEPF6DT	UNITS
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	Volts
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	Volts
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	150	200	Volts
Maximum average forward rectified current T_C=100°C	$I_{(AV)}$	6.0				Amps
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	100.0				Amps
Maximum instantaneous forward voltage per leg at 3.0A	V_F	0.975				Volts
Maximum DC reverse current T_A=25°C at rated DC blocking voltage T_A=100°C	I_R	5.0 50.0				µA
Maximum reverse recovery time per leg (NOTE 1)	t_{rr}	35.0				ns
Typical thermal resistance (NOTE 2)	$R_{\Theta JC}$	5.4				°C/W
Typical junction capacitance per leg (NOTE 3)	C_J	28.0				pF
Operating junction and storage temperature range	T_J, T_{STG}	-55 to +150				°C

NOTES:
(1) Reverse recovery test conditions: I_F=0.5A, I_r=1.0A, I_{rr}=0.25A
(2) Thermal resistance from junction to case per leg mounted on heatsink
(3) Measured at 1.0 MH_Z and applied reverse voltage of 4.0 Volts

GENERAL SEMICONDUCTOR®

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES FEPF6AT THRU FEPF6DT

FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE

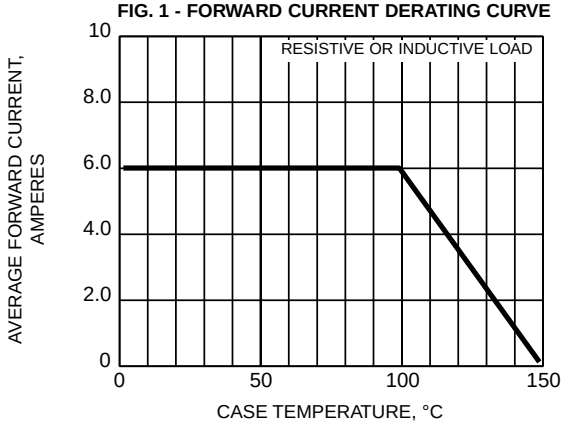


FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

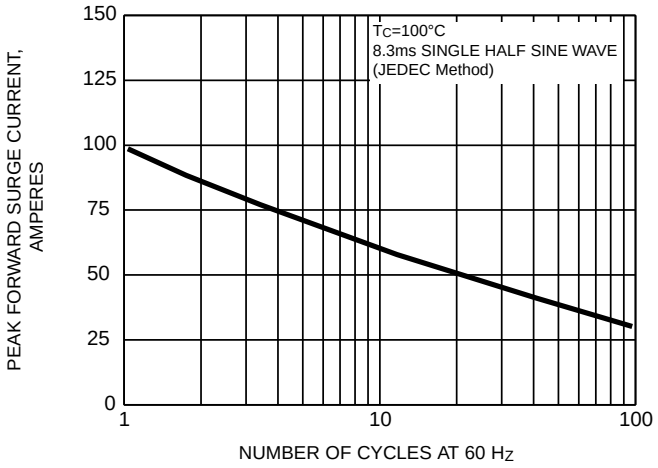


FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG

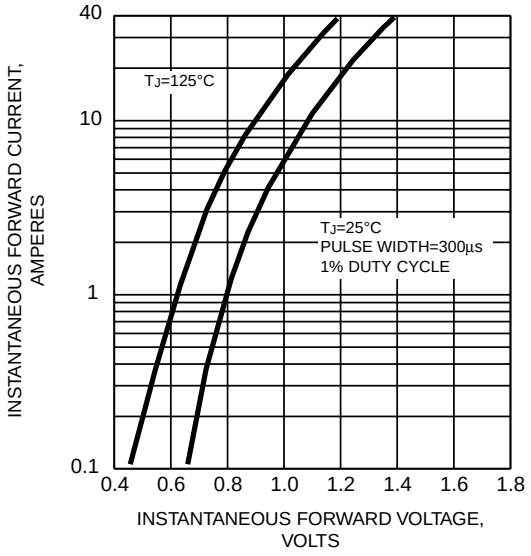


FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER LEG

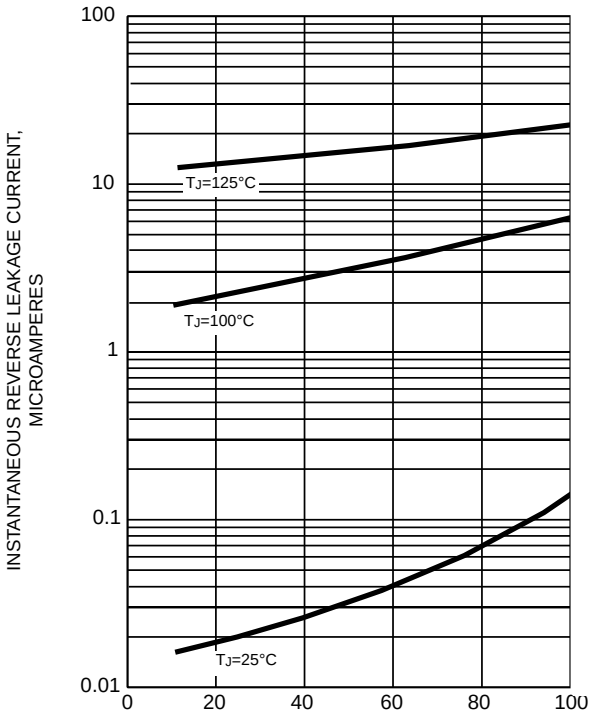
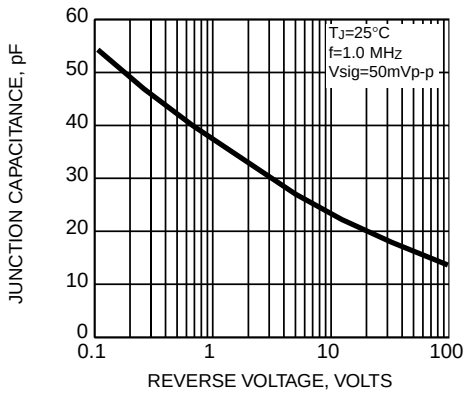


FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE PER LEG



GENERAL SEMICONDUCTOR®

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709